REMARKS

Applicants thank the Examiner for indicating that claims 8-14 and 16-18 are directed to patentable subject matter. Applicants have canceled claims 1-7, 19 and 20 and amended claims 8-18 to put base claim 8 in independent form and to conform the dependent claims to the amendments to claim 8, which is now directed solely to prior condition a3).

Applicants also attach for the record a complete copy of JP 4-136856, the original of the Kumada reference on whose abstract the Examiner relied in the pending Action.

Applicants also note block 12 of the Office Action Summary, which indicates that the certified copies of the priority documents have not been received. This application is a 371 of a PCT international application, so the certified copies should have been sent to the PTO by the International Bureau. Applicants request the Examiner to check the Office files on this point and acknowledge receipt of the certified copies.

Early action allowing claims 8-18 is solicited.

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent and Trademark Office determines that an extension and/or other relief is required, Applicants petition for any required relief including extensions of time and authorizes the Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to **Deposit Account No. 03-1952** referencing 360842008500.

Dated: November 17, 2004

Respectfully submitted,

By:

Barry E. Bretschneider Registration No. 28,055 Morrison & Foerster LLP 1650 Tysons Blvd, Suite 300 McLean, Virginia 22102

Telephone: (703) 760-7743 Facsimile: (703) 760-7777

⑩日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平4-136856

@Int.Cl. 5

: ,,,

識別記号。

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)5月11日

G 03 F 7/004

5 1 5 5 0 3 7124-2H 7124-2H

H 01 L 21/30

301 R*

審査請求 未請求 闘求項の数 1 (全 10 頁)

の発明の名称 感光性樹脂組成物

②特 頭 平2-262563

②出 願 平2(1990).9月27日

四発 明 者 熊 田

輝 彦

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

@ 発明者 田中 祥子

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

@ 発明 者 堀 辺 英 夫

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

⑩苑 明 者 久 保 田

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

の出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内 2丁目 2番 3号

⑩代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

最終頁に続く

19月 余田· **在**

1. 税前の名称

感光性树脂粗成物

2. 特許請求の範囲

(1) 放射線に感光して設または塩基を発生する化合物および一般式(I):

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH & R^2 \\
CH & CH & R^3 \\
CH & R^4 \\
CO - O - C - R^2 \\
R^6 & R^6
\end{array}$$

(式中、 R^I ー R^B はそれぞれ水衆原子、アルギル鉄、ハロゲン化アルキル器、アルコギシ器、アルケニル弦、アルギニル器、<u>フェニル語または関</u>

度フェニル基を示し、 R² と R³ 、 R⁵ と R⁶ が それぞれ理構選をなしていてもよい、 Arは労委権 を育する基を示す)で表わされる単位からなる化 合物を含有することを特徴とする磁光性樹脂和成 物。

3. 宛明の眸柳は疑明

(庶業上の利用分野)

本類明は、たとえば越LSI などの半球体デバイスの酸期バクーンを形成するために使用される飲制 蝦島応性レジストに用いる設光性樹脂組成物に関する。

〔従來の技術・類明が解決しようとする興姻)

使来から半媒体アバイスの高級故化が求められており、それに対応して微細加工技術の開発がかられている。この技術を実現するためにいけつかの手法が検討されているが、なかでも光リソクラフィー技術で使用する光線を短波氏化するためにエキシマレーがを移光線で使用することや、光学干渉などの問題を無視できる電子線、X線を軟光線域に使用した移光技術などが注目されてい

- 2 -

from TORAY

特朗平 4-136856(2)

- გ.

そこで、電子は、X級用のレジストとして、ポリメククリレート樹脂やポリオレフィンスルホン樹脂などからなるポジ型レジストや、クロロメチル化ポリスチレンなどからなる米が翌レジストが開発されている。しかし、前者はドライエッチング耐性が延く延感度であるという欠点を有し、後記は退像被による影問のために解像度が低下するという欠点を有している。

さらに、高感度のレジストをうるためのものと

ついて 記載されているが、 これらの組成物では解 重合による気体の発性が著しいために、 生成する パクーンの形状が悪化してしまう。

本発明は、前記のような健康の技術の問題点を解決し、放射線が光に対する高い感度を有し、形光された部分だけが忠爽に思性解談に可熔化し、かつ非極性溶鉱に不常化して高解像度のバクーンを形成しうるが必要としてもネガ裂としても使用しうる放射線感応レジストを提供することを目的

(無関を解決するための手段)

本配明者らは、前記目的を遊成すべく航建設計を重ねた結果、放射線に感光して設または塩族を 免出する化合物および一般式(I):

[四(下条日]

して、特別的 80-175046 号公報には、野光前はアルカリ 浴彼に対して溶解性抗性があり、放射線の防光を受けるとその部分がアルカリ可溶性となる組成物であって、アルカリ可溶性フェノール樹脂と放射線感応性オニウム塩との組成物が明示されており、特別的 68-58131号公報には、アルカリ可溶性の 高分子化合物と、高エネルギー放射線の限制によってエステルが分解し、カルボン酸を生成するアルカリ 不溶性有限酸エステルとの組成物が朗示されている。

しかし、前紀公報に開示されている知成物は、いずれも解像度、感度などの性能のある役更の向上はみられるものの、変用的なレベルにまで同上したものではない。

また、「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカルソサイアティ(J.Electrochon.Soc.) 138 (1)、 p. 241 ー 245 」には、トリフェニルスルポニウムヘギサフルオロアンチモネートが製外類の服射を受けて改を発生し、その設によるポリ(クロロまたはプロモフタルアルデヒド)の解析合に

(式中、 P¹ ~ P⁸ はそれぞれ水煮原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル蒸、アルコキシ痣、アルケニル底、アルコキシ痣、アルケニル底、アルキニル底、フェニル 基または 関係フェニル 基を示し、また 2² と R³ 、 R⁵ と R⁸ がそれぞれ環構造をなしていてもよい、Arは 芳香環を含有する 甚を示す) で 表わされる 単位 からなる 化合物を 含有する ことを 特徴とする 感光性 掛節組成物が、 高感度で高解像 皮の 放射線 感応レジストとなる ことを見出し、 本類明に 到途した。 「作 用 1

本発明の組成物に放射線が原射されると、放射 線に感光して限または進振を発生する化合物から

- 5 -

_ 6

充生した改または塩基が、アルカリ水体液などの低性係 塔に不常で非極性保保に可信の一般式(1)で設わされる単位からなる化合物の一部を分解し、その部分を極性溶媒に可溶で非極性溶媒に不然にする。その結果、極性溶媒を現像液に川いるとポン型のバターンを形成することができる。

また、この分解反応を起こすために必要な破または温塔を発出する化合物は、加熱することにより大幅に低度を向上させることが可能となるばあいが多い。

(蚁瓶树)

本発明の感光性樹脂組成物には、一般式(I): (以源永白)

- 7 **-**

チルアミノ茲、ジメチルアミノ語、エチルアミノ 茲、ジエチルアミノ茲、塩素原子、臭素原子、フッ衆原子など母校された関境フェニル基である。 $R^1 \sim R^8$ はそれぞれ間額でもよく、契種でもよ く、 R^2 と R^8 、 R^5 と R^8 がそれぞれ - Cll $_2$ Cll $_2$ Cll $_2$ Cll $_3$ Cll $_4$ Cll $_4$ Cll $_4$ Cll $_4$ Cll $_5$ Cll $_6$ Cll $_7$ Cll $_8$ Cll $_8$

特朗平 4-136856(3)

$$\begin{array}{c|c}
CO - O - C - R^{5} \\
CO - O - C - R^{5} \\
R^{4}
\end{array}$$
(1)

– 8 –

サントン、チオフェン、ベンソチオフェン、オキサソール、インオキサソール、チアソール、ベンソチアソール、オキサソリン、オキサソリジン、ベンソオキサチイン、イサチン、インドレニン、ピペリドン、イソキノリン、611- ピラン-4- オンなどから水常原子などを除いた抜かあげられる。これらの中では単年芳豊原が異ましい。

-- 9 --

- 10 -

特朗平 4~136856(4)

ドロキシ丞: アミノ差: メチルアミノ器、ジメチルアミノ語、エチルアミノ語、ジェチルアミノ語 などの収換アミノ語などで収換されていてもよい。 前記一般式(I)で表わざれる単位からなる化合物

は、1種の単位からなっていてもよく、2種以上の単位からなっていてもよい。

一般式(1)で表わされる単位の繰り返し数は、4~100、 さらには10~50であるのが好ましい。 設数が10米消では成該性が低下し、100 をこえると愉嫌に解けにくくなる傾向がある。

前記一般式(j)で扱わされる単位からなる化合物は、たとえば芳姿炊ジアルデヒドとマロン酸をピベラジンの存在下に脱水網合させ、芳香飲ジアクリル酸を合成し、これを常法によりエステル化することによってモノマーを合成したのち、このモノマーを高近水無灯の煎射によって光重合させることによりうることができる。

本発明に用いられる放射線に感光して配生たは 塩器を発生する化合物 (以下、酸または塩透発生 化合物ともいう) のうち、酸を発生する化合物の

- 11 -

フェイト、4-torl- ブチルフェニルジフェニルス ルポニウムトリフルオロスルネネイト、トリス(4 - メチルフェニル) スルホニウムチトラフルオロ ポレイト、トリス(4- メチルフェニル) スルホニ ウムヘキサブルオロアンチモネイト、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムヘキサフルオロア ルシネイト、トリス(4- メチルフェニル) スルホ ニウムヘキサフルオロホスフェイト、トリス(4-メチルフェニル) スルホニウムトリフルオロスル ホネイト、トリス(4- メトキシフェニル) スルホ ニウムテトラフルオロポレイト、トリス(4- メト キシフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアン チモネイト、トリス(4- メトキシフェニル) スル ホニウムヘキサフルオロアルシキイト、トリス(4 - メトキシフェニル) スルホニワムヘキサフルオ ロホスフェイト、トリス(4- メトキシフェニル) スルホニウムトリフルオロスルホネイト、ジフェ ニルヨウドニウムテトラフルオロボレイト、ジブ ェニルヨウドニウムヘキサフルオロアンチモネイ ト、ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアル

具体例としては、たとえばトリフェニルスルホニ · ワムテトラフルオロボレイト、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、トリフ ェニルスルホニウムヘキサフルオロアルシネイト。 トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフ ェイト、トリフェニルスルホニウムトリフルオロ スルホネイト、4-チオフェノキシジフェニルスル ホニウムテトラフルオロポレイト、4-チオフェノ キシグフェニルスルホニウムヘキサフルオロアン チモネイト、4-チオフェノキシグフェニルスルホ ニウムヘキサフルオロアルシネイト、4-チオフェ ノキシジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェイト、4-チオフェノキシジフェニルスルホ ニウムトリフルオロスルホネイト、4-tert- ブチ ルフェニルジフェニルスルホニウムチトラフルオ ロポレイト、4-tert- プチルフェニルジフェニル スルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4tarl- プチルフェニルジフェニルスルホニクムへ キサフルオロアルシネイト、4-tert- プチルフェ ニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホス

- 12 -

シネイト、ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオ ロホスフェイト、ジフェニルヨウドニウムトリフ ルオロスルホネイト、8.8'- ジニトロジフェニル ヨウドニウムテトラフルオロポレイト、3.5'- ジ ニトロジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロア ンチモネイト、8.8'- ジニトロジフェニルヨウド ニウムヘキサフルオロアルシネイト、B,8'- ジニ トロジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホス フェイト、8.5 - ジニトロジフェニル日ウドニウ ムトリフルオロスルホネイト、4.4'- ジメチルジ フェニルヨウドニウムチトラフルオロボレイト、 4.4'- ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフ ルオロアンチモネイト、4.4'- ジメチルジフェニ ルョウドニウムヘキサフルオロアルシネイト、4. 4'- ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフル オロホスフェイト、4.4'- ジメチルジフェニルコ ウドニウムトリフルオロスルホネイト、4,4-ジ Lart- ブチルジフェニルョウドニウムチトラフル オロポレイト、4.4-ジtart- プチルジフェニルヨ ウドニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4.4-

- 1'3 -

- 14 -

-616-

ジtart- ブチルジフェニルヨウドニウムヘキサフ ルオロアルシネイト、4.4-ジtori- プチルジフェ ニルョウドニウムヘキサフルオロホスフェイト、 4.4-ジ Lort- ブチルジフェニルョウドニウムトリ フルオロスルホネイトなどのオニウム塩や、2.4. 6-トリス(トリクロロメチル)トリアジン、2-ア リル-4.8- ピス(トリクロロメチル)トリアジン、 α, α, α- トリプロモメチル- フェニルスルホ ν. α, α, α, α'·α'·α'-ヘキサクロロキシ リレン、2.2-ピス(8.6- ジプロモ-4- ヒドロキシ フェニル)-1.1.1.1.3.3.3-ヘキサフルオロプロバン、 1,1,1-1-トリス(8.5- ジプロモ-4- ヒドロキシフェ ニル)エクンなどのハロゲン合育化合物や、(2-ニトロペンジルトシレイト、2.6-ジニトロペンジ ルトシレイト、2.4-ジニトロペンジルトシレイト、 メチルスルホン胶3-二トロペンジルエスチル、酢 胶 2-ニトロペンジルエステル、p-ニトロペンジル -8.10-ジメトキシアントラセン-2- スルホネイト、 1,2,8-トリス(メクンスルホニルオキシ)ペンゼ ン、1.2.8-トリス(エクンスルホニルオキシ)ベ

- 15 -

もよい。

アルカリ可溶性の高の ANH は A からのは、カーCOOII、 - COOII、 - COOII - C

アルカリ可溶性高分子化合物の配合量は、一股式(1) で設わされる化合物との合計重量に対して80%以下が作ましい。配合量が80%より多くなるとえられるレジスト膜がアルカリ可溶性となり、

特別平 4-136856(5)

ンゼン、1.2.3-トリス(プロバンスルホニルオキシ)ペンゼンなどのスルホン酸エステルなどがあげられる。これらは用独で用いてもよく、2種以上を供用してもよい。

また、協芸を発生する化合物の具体例としては、たとえばトリフェニルメタノール、その誘導体、ローニトロペンジルカルバメートなどがおげられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

門記一般式(I)で数わされる単位からなる化合物と設または塩態発生化合物の配合割合は、一般式(J)で表わされる単位からなる化合物/股または塩産発生化合物が受量比で70/80~89/1、さらには80/20~88/2 であるのが好ましい。 前記一般式(I)で数わされる化合物が88/1をごえるとバターニングが行ないにくくなる領向があり、70/80未満では相溶性が低下して均一にしくくなる。 成されるパターンの不良が発生しやすくなる。

また、レジスト膜の形成をさらに容易にするために、アルカリ可存性の高分子化合物を配合して

- 16 -

バターンの形成が困難になる。

きらに本売明の組成物には、基板とレジストとの 常智性を向上させるためのアミノシラザン、アミノアルコキシシラザン、アルキルアルコキシシラザンなどの密替性向上剤をはじめ、その価必要に応じて目的にあった化合物を配合してもよい。

本類明の樹脂組成物は、通常、 前記の成分を溶 媒に溶解させて、 レジスト溶液として使用される。

前記格棋としては、前記成分を容解し、かつそれのと反応しないものであればとくに限定さらのがほこのできるが、 赤点が 100'でより 低い もので せいららができせい。 海点が 220 で で とり 低い のので は 20 で で とり がって させにくく なる。 このような 冷蛇の 異体例として は、 たとえばメデルセロソルブ、 エチイム シロソルブ、 ジメデルグライム、 ジエティン クロペンタノン、 かって イム、 シクロペキサノン、 ャーブ ないあげられる。

前記レジスト斧液を、たとえばシリコンウェハ

- 1 S

- 17 -

特別平 4-136856(6)

などの選択上にスピンコート法などの方法によって乾燥調度が 0.2 ~ 2 四母度になるように堕布し、プリペイクし、UV光、ディーブUV光、軟工線、電子線などの放射線を駆射したのち、80~150 で程度で 80秒~20分間加熱し、ついで現像を行なうことによってパターンが形成される。

レジストの現像被としては、アルカリ性水溶液 または有限溶媒を用いることができる。また、極 性溶媒を用いるとポジ型のパターンを形成するこ とができ、非枢性溶媒を用いるとネガ型のパター ンを形成することができる。

アルカリ性水溶液としては、たとえばアンモニア、トリエチルアミン、ジメチルアミノメクノー・ル、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、次酸ナトリウム、コリンなどの水溶液があげられる。

また有限溶解としてはジクロロメタン、クロロボルム、トリクロロエチレン、酢酸エチル、酢酸イソアミル、メタノール、イソプロパノール、これらの混合溶解などがあげられる。

- 19 -

ったところ、0.30mのラインアンドスペースのネガ双パクーンが解棄できた。

さらに前記レジスト駅に加速電圧20kyの電子様を1.5 μ C/d で照射し、100 ℃で5分関加熱した。そののち、前記と同様にして2.88%テトラメチルアンモニウムヒドロキンド水溶被またはクロロホルム/メタノールが3/1の過合溶媒で現除したところ、エキシマレーザを照射したときと同様に良好なポジ製パターンと木が型パターンがえられた。

契 瓶 例 2 ~ 82

第1数に示す扱を有する一般式(I)で扱わされる 単位からなる化合物(化合物2~21)を用い、到 2数に示す机成のレジスト溶液を四辺したほかは 実態例1と同様にしてレジスト腺を作設し、エキ シマレーザまたは加速度圧20kVの電子線を形光し、 2.88%テトラメチルアンモニウムヒドロキシドま たはクロロホルムノメタノールが3/1の鑑合物 鉄で現像を行なって、感度と解像度を調べた。鉛 果を第2級に示す。 以下に本館明の租政物を実施例によってさらに 異体的に説明するが、本勢明はこれらに限定されるものではない。

此施例1

第1数に示す基を有する一般式(I) で表わされ お単位からなるポリ(p- フェニレンジアクタとトリ ジー1ertープチルエステル) (化合物 1) 2gとトリ フェニルポスホニウムトリフレイト 0.1gを 10aiの シクロヘキサノンに溶解させて腐製したレジスト 溶液を、シリコン基板上に 3000 rpa で スピンコー トし、 80でで 15分間加熱してレジスト 態に &r た。 このときの段厚は 2 mであった。 このを た。 このときの段厚は 2 mであった。 このを たた このともの で 100 でで 5 分間加熱した。

そののち2.88%チトラメチルアンモニウムヒドロキシド水倫波で60秒間限像を行なったところ、0.80mのラインアンドスペースのポジ盟バターンが外像できた。

また、現像被モクロロホルム/メタノールが 3/1 (容額比) の混合溶媒にかえて現像を行な

- 20 -

第2数より、いずれの実施例でも0.50m以下の 解像度と30mJ/間以下の限度がえられていること がわかる。



- 2.1 -

- 22 -

ξý.

特開平 4-136856(7)

第 1 章

| | | | | sp i | 24 | | | |
|---------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 化合物 番 号 | - A r | R 1 | R ² | R ⁸ | R4 | R s | R € | 数平均 分子量 |
| 1 | · | - C#1 | - CH ₂ | - C1f3 | - СН3 | - CII3 | - CII 1 | 8,500 |
| 2 | | - Cila | - C113 | - CH ₄ | - CB3 | - ¢#3 | - CIIs | 11,000 |
| 3 | | - CH _a | - CHa | - сяз | - Cli ₂ | - Cff3 | - Cli ₃ | 5, 000 |
| 4 | - ◇ | - CH ₃ | - Cff3 | - C ₂ N ₅ | - сн3 | - CII3 · | - C z II 5 | 3, 800 |
| 5 | ,, | - CH3 | - C2 115 | - C2 H5 | - CH ₃ | - C₃ A₅ | - C1 H5 | 4,200 |
| 6 | " | - CH3 | - Clia | - CII - CII ; | - 6113 | - cita | - CB - CB z | 7.700 |
| 7 | " | - C113 | - СН3 | - C = CII | - сна | - CK ² | C= CII | 5. 200 |
| 8 | " | - CH ₃ | - Citz | | - CH ₃ | - CR³ | | 8, 900 |
| 9 | <i>A</i> | - CH3 | —Сн3 сп5 | CIT & CIT & CIT & — | - CR3 | -c112 c11 | z Cii z Cii z Cii z— | 6, 500 |
| 10 | ,** | -11 | — сн _з св | 2 CH2 CH2 0 - | - n | — C11 ₂ C | H 2 C H 2 C H 2 O - | 5,000 |
| 1) | ÇH3 | ~ CK₃ | - CH ₂ | - CII3 | - CN2 | - CII3 | - CH3 | 3, 300 |
| 12 | CH ³ | - сп; | - С Н з | - CH ₃ | - СНа | - СН3 | - CH3 | 4,100 |
| | | | | | | | | |

.4

特朗平 4-136856(8)

| ~ ^ ^ | ~~~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~ | \sim | ~~ | ~~~ | ~~~ |
|-------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| | Ce | | | | | | | |
| 19 | | -C H ₂ | - CH ₃ | - CH ₃ | - CU3 | - CII3 | - CH 3 | 3,700 |
| 14 | OCH? | - CH ₂ | ~ CH3 | - cn ₁ | - CH ₃ | - cn ₂ | - C113 | 5,100 |
| . J 5 | OH | - CH ₃ | - CIfa | - C II 3 | - Cils | - CB ₃ | - Gll2 | 3, 300 |
| 16 | | - CII3 | - CH2 | - CH3 | - Cu3 | - c113 | - C 11 ₃ | 8,000 |
| 17 | | - Cita | - CH ₃ | - cu² | - сиз | - cu² | - CII3 | 5,200 |
| 1'8 | \mathcal{L}_{s} | + Ciis | - CII ₂ | - cn3 | - CIIa | - cii² | - C113 | 3,800 |
| 19 | $\mathcal{L}_{\mathfrak{o}}$ | - CH ₃ | - С Н з | - CH3 | - C1[1 | - CH3 | ₍₎ - CH ₃ | 2, 30,0 |
| 20 | ← > | - ¢112 | - CH3 | - Cfl2 | - CH ₃ | - CII3 | ~ C II 3 | 5,400 |
| 2 1 | • | ~ CH3 | - CH ₃ | - C11 ₈ | - C163 | ~ Cita | + CH ₂ | 7,000 |

_ 24 -

特爾平 4-136856(9)

| | T | | | 1 | | | | | • • • | - |
|---------|----------|--------------------|-------|-------|------|--------------------|------------|--------|------------------|--------------------|
| 爽旅例 | 化合物铅号 | 酸またに | 拉拉达 | ig | 槛 | 添加ポ | リマー | HS. | 庭 | 解像度 |
| 舒 号 | (2) | %生化合 | 物 (E) | (m | 1) | (g) | | (mJ/cm | 1 ²) | (₄ m,) |
| 3. | 1 (2,0) | TPSTP*1 | (0.1) | CH#7 | (10) | _ | | 8 | | 0.30 |
| 2 | 1 (2.0) | | (0.1) | DC#8 | (10) | - | | 12 | | 0.95 |
| 3 | 1 (2.0) | ייידיועה ו | (0.1) | | (10) | _ | | 7 | | 0.80 |
| 2345678 | 1 (2.0) | | | BS#8 | (10) | _ | | 15 | | 0.40 |
| 5 | 1 (2.0) | I TDMT∪ | (0.B) | | | l - | | 30 | | 0.50 |
| 6 | 1 (2.0) | тири ^{*6} | (0.2) | WV#TO | (10) | J .=. | | 20 | | 0.50 |
| 7 | 1 (1.5) | TPSTF | (0.1) | CII | (10) | PVP*11 | (0.5) | В | | 0.80 |
| 8 | 1 (1.7) | TPSTF | (0.2) | DG | (10) | CNOV*12 | (0.3) | 10 | | 0.40 |
| 9 | 2 (2.6) | HPIFP | (0.1) | CH | (10) | ` - | | 35 | | 0.45 |
| 10 | 2 (1.5) | TPSTP | (0.1) | P.S | (10) | PVP | (0.5) | 8 | | 0.30 |
| 11 | 2 (1.8) | TAND | (0.2) | DC | (10) | CNOV | (0.2) | 12 | | 0,40 |
| 12 | 2 (1.8) | TPSTF | (0.1) | AA | (10) | PAA+13 | (0.2) | 10 | | .0.40 |
| 13 | 9 (2.0) | TPSTP | (0.1) | CH | (10) | _ | | 8 | | 0.80 |
| 14 | 8 (1.5) | TPSTF | (0,2) | DC | (10) | PYP | (0.5) | 9 | | 0.85 |
| 16 | 4 (2.0) | THSU | (0.1) | CII | (10) | . – | | 8 | | 0.90 |
| 16 | 5 (2.0) | TPSTF | (0.1) | ES | (10) | - | • | 10 | | 0.95 |
| 17 | 8 (2.0) | TPSTF | (0,1) | DC | (10) | _ | | 12 | | 0.40 |
| 18 | 7 (1.7) | NP1PP | (0.2) | AA | (10) | CHOY | (0.3) | 16 | | 0.45 |
| 19 | 8 (1.8) | TPSTF | (0.1) | СН | (LD) | PHA ^{¥14} | (0.2) | 8 | | 0.30 |
| 20 | 9 (2.0) | TPSTF | (0,2) | DO | (10) | - | | 70 | | 0.35 |
| 21 | 10 (2.0) | Takd | (1.0) | CH | (10) | ! - | | 1,5 | | 0.45 |
| 22 | 11 (2.0) | TPSTF | (0.1) | ES | (10) | | 4 \ | 12 | | 0.85 |
| 28 | 12 (1.8) | TPSTP | (0.2) | DG | (10) | PAA | (0.2) | 8 | | 0.80 |
| 24 | 13 (2.0) | TPSTF | (0.1) | AA | (10) | - | | 10 | | 0.35 |
| 25 | 14 (2.0) | THSB | (0.1) | CB | (10) | - | | 7 | | 0.80 |
| 28 | 15 (2.0) | TPH | (0.3) | DG | (10) | | 40 61 | 80 | | 0.50 |
| 27 | 16 (1.5) | TPSTF | (0.1) | CII | (10) | qyq | (0.5) | 8 | | 0.85 |
| 28 | 17 (1.8) | Malab | (0.1) | E\$ | (10) | PNA | (0.2) | 12 | | 0.40 |
| 29 | 18 (2.0) | TPSTP | (0.1) | DG | (10) | - | | 10 | | 0.40 |
| 30 | 19 (3.0) | TPSTP | (0.1) | AA | (10) | _ - | | 8 | | 0.80 |
| 81 | 20 (2.0) | ТИРИ | (0.2) | CII | (10) | mm = | 46 51 | 20 | | 0.50 |
| 32 | 21 (1.5) | TPSTF | (0,1) | CH | (10) | PYP | (0.5) | 8 | | 0.35 |

ಌಹಕ.

特朗平 4-136856(10)

(形切の効果)

本発明の感光性樹脂組成物は、放射線弱光に対して高い感度と高い解像度を育する感光性樹脂制度物であり、放射線感応レジスト材料として極めて行用であり、放調パクーンが必要とされる超 USI などの準定体デバイスの製造にとくに有用である。

代羽人 火岩岩堆

- 26 -

第1頁の続き

SInt. Cl. 5

識別記号

宁内松柳悉县

H 01 L 21/027

個 元 明 名 肥 塚 裕 至 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 材料研究所内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.